



	<h2>SI1065X-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI1065X-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 1.18A SC89-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1065X-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI1065X-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 1.18A SC89-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	9000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 236mW (Ta) Surface Mount SC-89-6
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Verlustleistung (max)	236mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	156 mOhm @ 1.18A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	950mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.8nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	480pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1065X-T1-GE3TR

SI1065X-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1065X-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1065X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1065X-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1067X-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.06A SOT563F</p>	 <p><b>SI1067X-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.06A SC89-6</p>	 <p><b>SI1065X-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 1.18A SC89-6</p>	 <p><b>SI1065-A-GM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 36-WFQFN</p>
 <p><b>SI1065X-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 1.18A SOT563F</p>	 <p><b>SI1069X-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 0.94A SC89-6</p>	 <p><b>SI1067X-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.06A SC89-6</p>	 <p><b>SI1065-A-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 36-WFQFN</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ SI1040X-T1-E3	↔ SI1040X-T1-GE3	⇒ SI1040X-T1-GE3	D SI1041ADY	↔ SI1041DY-T1
⊣ SI1041DY-T1-E3	⊛ SI1045AB	D SI1045ADY-T1	⇒ Si1046X-T1-E3	↔ SI1046X-T1-GE3
⊛ SI1046X-T1-GE3	⊣ SI1050X-T1-E3	⊛ SI1050X-T1-E3	↔ SI1050X-T1-GE3	↔ SI1050X-T1-GE3
D SI1051X-T1-GE3	⊛ SI1051X-T1-GE3	⊣ SI1056X-T1-E3	⊛ SI1056X-T1-E3	↔ SI1056X-T1-GE3
⇒ SI1056X-T1-GE3	↔ SI1058X-T1-GE3	⊛ SI1058X-T1-GE3	⊣ SI1065X-T1-E3	↔ SI1065X-T1-E3
↔ SI1065X-T1-GE3	⇒ SI1067X-T1-E3	D SI1067X-T1-E3	⊛ SI1067X-T1-GE3	⊣ SI1067X-T1-GE3
⊛ SI1069X-T1-E3	D SI1069X-T1-E3	⇒ SI1069X-T1-GE3	↔ SI1069X-T1-GE3	↔ SI1070X-T1-E3
⊣ SI1070X-T1-E3	⊛ SI1070X-T1-GE3	↔ SI1070X-T1-GE3	⇒ SI1071X-T1-GE3	↔ SI1071X-T1-GE3
⊛ SI1072X-T1-E3	⊣ SI1072X-T1-E3	⊛ SI1072X-T1-GE3	D SI1072X-T1-GE3	↔ SI1073X-T1-GE3
↔ SI1073X-T1-GE3	⊛ SI1120-A-GMR	⊣ SI1132-A10-GMR	⊛ SI1133-AA00-GMR	↔ SI1133DP-T1-GE3

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited